

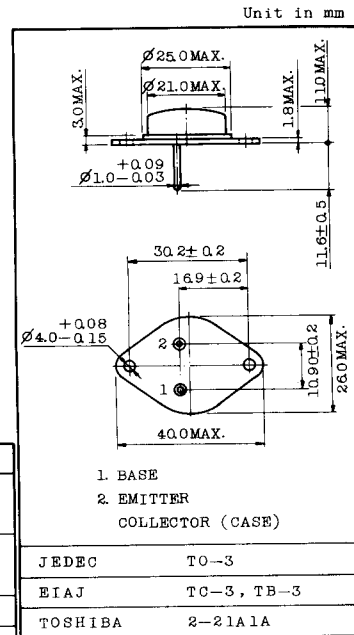
シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SB555  
2SB556

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- ・ コレクタ損失が大きい。 :  $P_C=100W$  (2SB555, 2SB556)
- ・ 高耐圧です。 :  $V_{CE0}=-140V$  (2SB555)  
:  $V_{CE0}=-120V$  (2SB556)
- ・ 2SD425, 2SD426 とコンプリメンタリになります。
- ・ 大電力ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。  
 $P_O=80W$  (2SB555),  $P_O=60W$  (2SB556)
- ・ Complementary to 2SD425 and 2SD426.
- ・ Recommended for High-Power High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SB555	-140	V
	2SB556	-120	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SB555	-140	V
	2SB556	-120	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-12	A
エミッタ電流	$I_E$	12	A
コレクタ損失 (Tc = 25°C)	$P_C$	100	W
接合温度	$T_j$	150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-65 ~ 150	°C



アクセサリはAC73を適用  
MOUNTING KIT No. AC73

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-60V, I_E=0$	-	-	-100	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-5V, I_C=0$	-	-	-100	$\mu A$
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SB555	$I_C=-0.1A, I_B=0$	-140	-	-	V
	2SB556		-120	-	-	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-10mA, I_B=0$	-5	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$ (Note)	$V_{CE}=-5V, I_C=-2A$	40	-	140	
コレクタ・エミッタ 間飽和電圧	2SB555	$V_{CE(sat)}$	-	-	-3.0	V
	2SB556					
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-7A$	-	-	-2.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=-5V, I_C=-2A$	-	6	-	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	-	330	-	pF

Note :  $h_{FE}$  区分 /  $h_{FE}$  classification R : 40 ~ 80, O : 70 ~ 140